

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年5月30日(2013.5.30)

【公開番号】特開2011-253987(P2011-253987A)

【公開日】平成23年12月15日(2011.12.15)

【年通号数】公開・登録公報2011-050

【出願番号】特願2010-127802(P2010-127802)

【国際特許分類】

H 01 L 31/10 (2006.01)

【F I】

H 01 L 31/10 A

【手続補正書】

【提出日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

実施の形態2.

図8は、実施の形態2に係る半導体受光素子を示す断面図である。n型InP基板32の裏面は曲面である。これにより、n型InP基板32の裏面で反射されて半導体発光素子に戻る反射光が更に小さくなるため、戻り光不良を更に確実に防ぐことができる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

実施の形態3.

図9は、実施の形態3に係る半導体受光素子を示す断面図である。n型InP基板32の裏面は、斜めにカットされて、入射光の入射方向に対して傾いている。これにより、n型InP基板32の裏面で反射されて半導体発光素子に戻る反射光が更に小さくなるため、戻り光不良を更に確実に防ぐことができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0024】

実施の形態4.

図10は、実施の形態4に係る半導体受光素子を示す断面図である。n型InP基板32の裏面は、n型InP基板32の表面やn型InP層36の表面などに比べて荒れてい。これにより、n型InP基板32の裏面で反射されて半導体発光素子に戻る反射光が更に小さくなるため、戻り光不良を更に確実に防ぐことができる。